

## 650V N-channel GaN FET in TO220-4L

## GP16520TD4

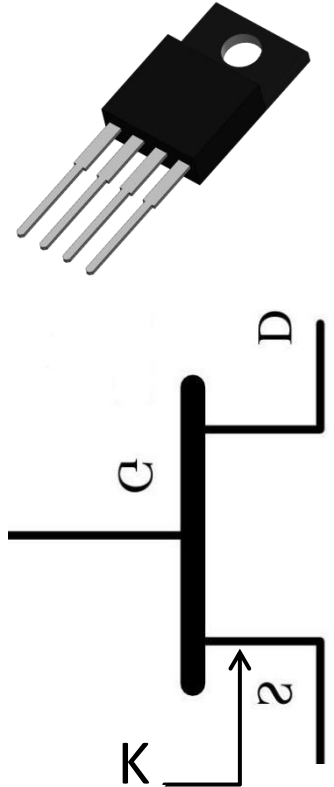
产品摘要 (典型)	
R <sub>DS(on)</sub> (mΩ)	87
Q <sub>rr</sub> (nC)	52
V <sub>DS</sub> (V)	650

### 产品特点：

- 低 QRR
- 无需续流二极管
- 用于降低 EMI 的高端安静标签™
- 开尔文引脚
- 高频操作

### 产品应用：

- 紧凑型 DC-DC 变换器
- 交流电机驱动
- 电池充电器
- 开关电源



极限参数 (T <sub>C</sub> =25 °C 若无特殊说明)			
符号	参数名称	极限值	单位
ID 25° C	漏极电流 (直流) @T <sub>c</sub> =25 ° C	26	A
ID 125° C	漏极电流 (直流) @T <sub>c</sub> =125 ° C	11.4	A
IDM	漏极脉冲电流 (pulse width:50 us)	52	A
VDSS	漏源击穿电压	650	V
VGSS	栅源电压 (直流)	±6	V
TJ	结温工作温度	-55 to 150	° C
PD 25° C	漏极最大允许耗散功率	110	W
TS	贮存温度	-55 to 150	° C
TCsold	焊接峰值温度b	260	° C

耐热性			
符号	参数名称	典型值	单位
R <sub>θ</sub> JC	结壳热阻	1.2	° C /W

电气特性 (T <sub>C</sub> =25 °C 若无特殊说明)						
符号	参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
<b>静态</b>						
VDSS-MAX	漏源击穿电压	650			V	VGS=0 V, ID=2 μA
						VGS=0 V, ID=200 μA
VGS(th)	栅极阈值电压		1.4		V	VDS=0.1, ID=24 mA
RDS(on)	漏源通态电阻 (T <sub>J</sub> = 150 °C)		179.5		mΩ	VGS=6V, ID =10A, T <sub>J</sub> = 150 °C
RDS(on)	漏源通态电阻 (T <sub>J</sub> = 25 °C)		87		mΩ	VGS=6V, ID =10A, T <sub>J</sub> = 25 °C
IDSS	漏极漏电流测试		1.78		μA	VDS=650V, VGS=0V, T <sub>J</sub> = 25 °C
			20		μA	VDS=650V, VGS=0V, T <sub>J</sub> = 150 °C
IGSS	漏极正向漏电流		34		μA	VGS= 6 V, VDS=0V, T <sub>J</sub> = 25 °C
	漏极正向漏电流		672		μA	VGS= 6 V, VDS=0V, T <sub>J</sub> = 150 °C
<b>动态</b>						
CISS	栅短路共源输入电容		170		pF	Vds=400V, Vgs=0, f=1MHz
COSS	栅短路共源输出电容		56			
CRSS	栅短路共源反向传输电容		1			
Qg	总栅极电荷b		3.8	-	nC	Vds=400V, Id=1A, Vg=0~6V
Qgs	栅源电荷		0.2			
Qgd	栅漏电荷		2.2			
td(on)	开通延迟时间		6.2		ns	Vgs=400V, Vgs=0~6V, Id=10A, Rg=5 Ohm, Wheeling Diode=G-S Shorted DUI
tr	上升时间		12.7			
Td(off)	关断延迟时间		5.8			
tf	下降时间		10			
Rg	Gate Resistance		1.1		Ω	Vs=Vd=0V, Vg=2V, f=1MHz
Rdson (Dynamic)	Dynamic Rdson		1.3		Ratio	Vds=400V, Id=2A, f=10KHz, duty=10%
<b>反向特性</b>						
ID-VD	源极反向电流		52	-	A	VGS=6V, VDS=10V, Pulse Width=50us
VSD	源漏反向电压		2.7		V	VGS=0V, ISD=10A
trr	反向恢复时间		14		ns	Vr=400V, If=10A, dI/dt=100A/us
Qrr	反向恢复充电电量		52		nC	

